



エンジニアリングセラミックス Si_3N_4 (Silicon Nitride) 基板

特徴

- Probe Card用 基板
- レーザー加工に最適
- HIP処理を施し、反りを低減。ポア30μm以下。
- 標準材；100角、150角 厚み；0.2~0.4mm
- 色；黒 平坦度；50μm



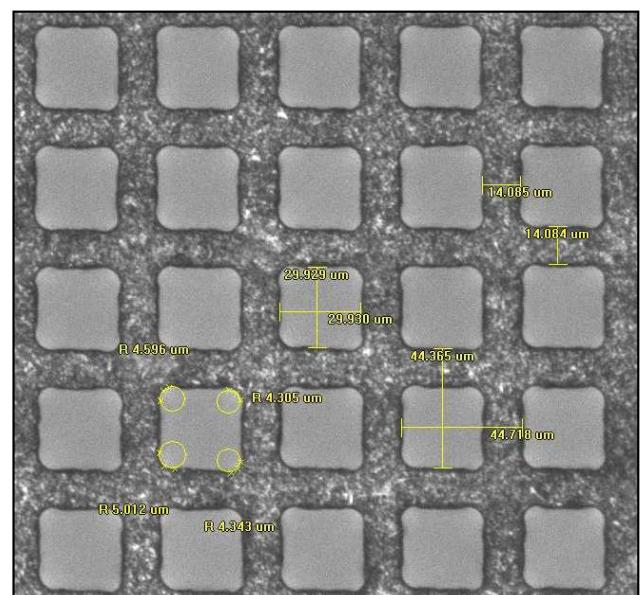
HIP Si3N4成分

HIP Si3N4成分	
Al2O3	<10%
Y2O3	
Fe2O3	<0.5%
CaO	<1.0%
MgO	
Na2O	<0.1%
K2O	
Si3N4	>88%

物性

HIP Silicon Nitride

		HIP	
Density	g/cm3	3.26	
Water Absorption	%	0	
Mechanical Characteristics	Vickers Hardness (Load 5KG)	Gpa	15
	Flexural Strength	Mpa	1000
	Compressive Strength	Mpa	3900
	Young's Modulus of Elasticity	Gpa	310
	Poisson's Ratio	-	0.28
	Fracture Toughness	Mpa·m ^{1/2}	7
Thermal Characteristics	Coefficient of Thermal Expansion	40-400	*10-6/°C
	Thermal Conductivity	20 °C	W(m·K)
Electrical Characteristics	Volume Resistivity	20 °C	Ω·cm
	Dielectric Constant (1MHz)	-	≥10 ¹⁴



ラックデザイン株式会社

TEL; 0944-85-9536

E-mail; info@luckdesign.jp